

а 2011 0026

Изобретение относится к способам получения полупроводниковых материалов и может быть использовано в полупроводниковой технологии.

Способ получения монокристалла ZnSe состоит в выращивании монокристалла ZnSe из газовой фазы при температуре 900...1100°C, с градиентом температур в зоне кристаллизации 1...5°C/см и со скоростью нагрева заправки и охлаждения выращенного кристалла 20...60°C/час, при этом задают неравномерное распределение температуры печи.

П. формулы: 1

Фиг.: 5